

单晶N型硅片(10A8N)

182.3x188



几何参数

边宽	短边:182.3±0.25mm,长边:188±0.25mm
对角线	256mm, 公差±0.25mm
厚度	130(+8/-8)μm
弧长投影	182 边长:4.27±0.5mm,188 边长:4.14±0.5mm

电学性能

电阻率	0.6-1.6Ω·cm
少子寿命	≥1000μs
氧含量	≤5.75×10 ¹⁷ at/cm ³
碳含量	≤5×10 ¹⁶ at/cm ³

材料性能

生长方法	CZ(拉直)法
晶向	<100>±2°

表面性能

TTV	≤20
翘曲度	≤40
线痕	≤13
边缘崩边	深度≤0.3mm,长度≤0.5mm,不多于一处
裂纹和穿孔	目测不可见
硅片表面	干净, 无油污、肥皂和胶水等残留物